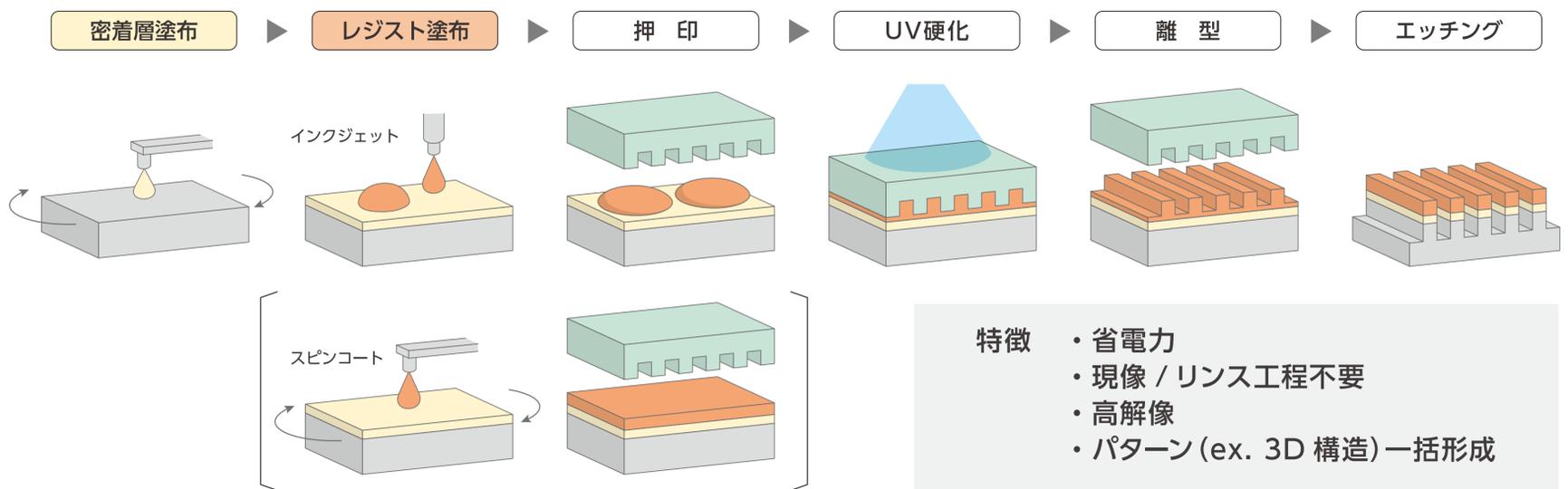


ナノインプリントリソグラフィ

技術・製品の概要説明

ナノインプリント (NIL) 技術



Fujifilm NIL材料

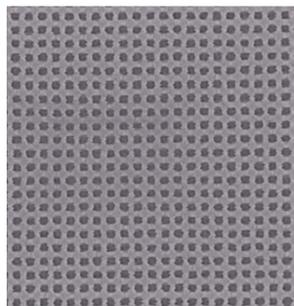
先端半導体リソグラフィ用 UV 硬化 NIL レジスト

- ・高解像マスクパターン (十数 nm) を忠実に転写し、複雑なパターンでも一括形成可能。先端半導体製造のコスト低減、省電力化に貢献。

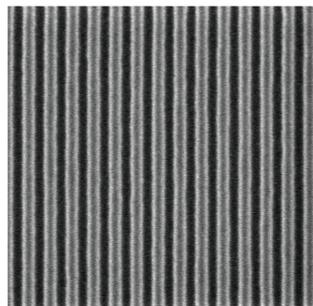
NIL 密着材

- ・高速な離型プロセスにおいてもレジスト転写パターンの欠損を防ぐため、基材とレジストの密着性を付与。

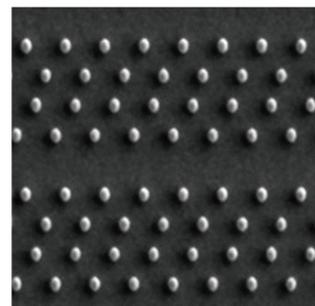
レジストパターン



hp 18 nm C/H



hp 19 nm L/S



24 x 40 nm Pillar

(データ提供：キヤノン株式会社様)

NILプロセス展開例

